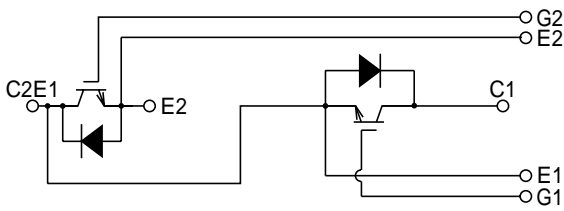
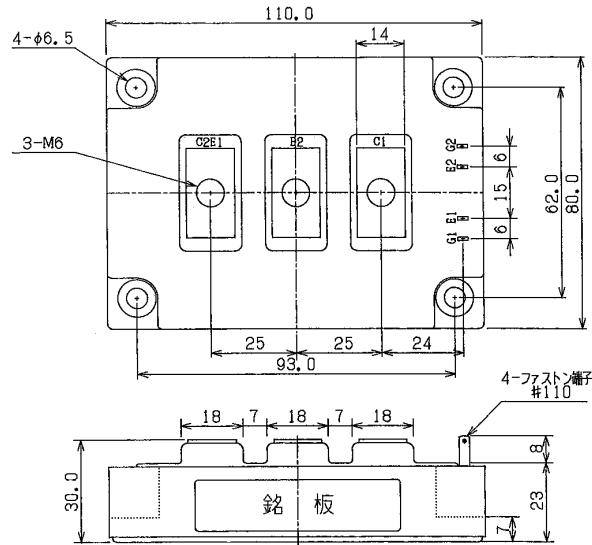


IGBT	400 A 1200 V	PDMB400C12
------	--------------	------------

回路図 CIRCUIT



外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



質量:650g(標準値)

最大定格 Maximum Ratings (  $T_c = 25$  )

項目 Item	記号 Symbol	定格値 Rated Value	単位 Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	$V_{CES}$	1200	V
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	$V_{GES}$	$\pm 20$	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	$I_c$	400
	1ms	$I_{CP}$	800
順電流 Forward Current	DC	$I_F$	400
	1ms	$I_{FM}$	800
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	$P_c$	2500	W
接合温度 Junction Temperature Range	$T_j$	- 40 ~ + 150	
保存温度 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	- 40 ~ + 125	
絶縁耐圧(端子 - ベース間, AC 1 分間) Isolation Voltage(Terminal to Base, AC 1 min.)	$V_{iso}$	2500	V(RMS)
締付トルク Mounting Torque	ベース取付部 Module Base to Heatsink	$F_{tor}$	3 (30.6)
	端子部 Busbar to Terminal		

電気的特性 Electrical Characteristics (  $T_c = 25$  )

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V$			8.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	$I_{GES}$	$V_{GE} = \pm 20V, V_{CE} = 0V$			1.0	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_c = 400A, V_{GE} = 15V$		2.6	3.3	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 5V, I_c = 400mA$			10.0	V
入力容量 Input Capacitance	$C_{ies}$	$V_{CE} = 10V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$		40000		pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	$V_{CC} = 600V$ $R_L = 1.5$ $R_G = 1.5$ $V_{GE} = \pm 15V$		0.25	0.45	$\mu s$
	ターン・オン時間 Turn-On Time			0.35	0.70	
	下降時間 Fall Time			0.25	0.35	
	ターン・オフ時間 Turn-Off Time			0.7	1.00	
順電圧 Peak Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 400A, V_{GE} = 0V$		2.5	3.3	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F = 400A, V_{GE} = - 10V$ $di/dt = 800A/\mu s$		0.2	0.3	$\mu s$

## 熱的特性 Thermal Characteristics

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	接合部 - ケース間 Junction to Case			0.065	/W
	Diode				0.14	